

ワイドギャップ半導体のその他の特徴

容量成分が小さい



スイッチングスピードが
速くなる



スイッチング周波数が
高くなる



受動部品 (LやC) を
小さくできる

製品がより小型に！

Transistor	Power rating	Input capacitance	Output capacitance	Reverse transfer capacitance
SiC MOSFET (SCT20N120)	1200V 20A	650pF	65pF	14pF
Si MOSFET (IXFX 20N120)	1200V 20A	7400pF	550pF	100pF
GaN HEMT (IGLD60R070D1)	600V 60A	380pF	72pF	0.3pF
Si MOSFET (SiHG70N60AEF)	600V 60A	5348pF	238pF	7pF

